



性能特点：

- 射频 (RF) /本振 (LO) 频率：2-20GHz
- 中频 (IF) 频率：1-10GHz
- 变频损耗：7dB
- LO-RF 隔离度：16dB
- LO-IF 隔离度：18dB
- RF-IF 隔离度：27 dB
- 本振功率：12dBm
- 产品尺寸：20.1mm×19.5mm×8 mm

产品简介：

XMx-0220 是一款金属外壳气密封装的无源三平衡超宽带混频器模块。本款产品能够实现 2-20GHz 频带内上变频或者下变频功能，中频频率覆盖 1-10GHz，典型带内变频损耗为 7dB。

电参数：（ TA = 25℃，本振驱动功率 12dBm，IF=1GHz ）

指标	最小值	典型值	最大值	单位
射频 (RF) 频率范围	2~20			GHz
本振 (LO) 频率范围	2~20			GHz
中频 (IF) 频率范围	1~10			GHz
变频损耗	5.8	7	9	dB
LO-RF 隔离度	7	16	19	dB
LO-IF 隔离度	11	18	23	dB
RF-IF 隔离度	20	27	35	dB
射频输入 P1dB	-	6	-	dBm

使用极限参数：

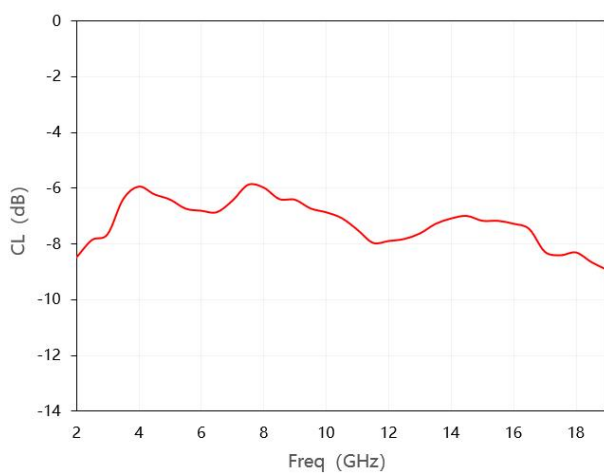
本振输入功率	22dBm
射频输入功率	20dBm
存储温度	-65℃~150℃
使用温度	-55℃~85℃

注：超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏。

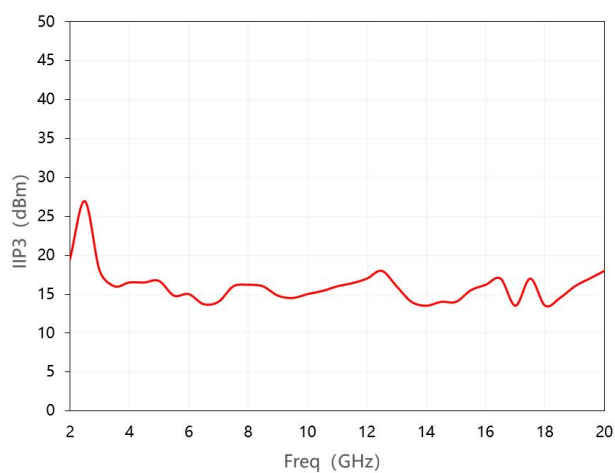


典型曲线 : (IF=1GHz)

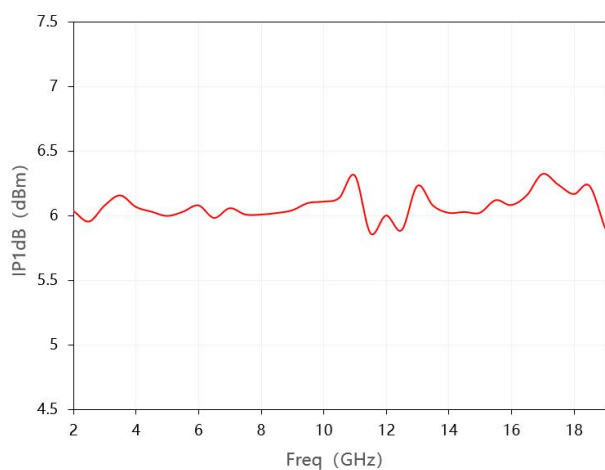
变频损耗 VS 频率



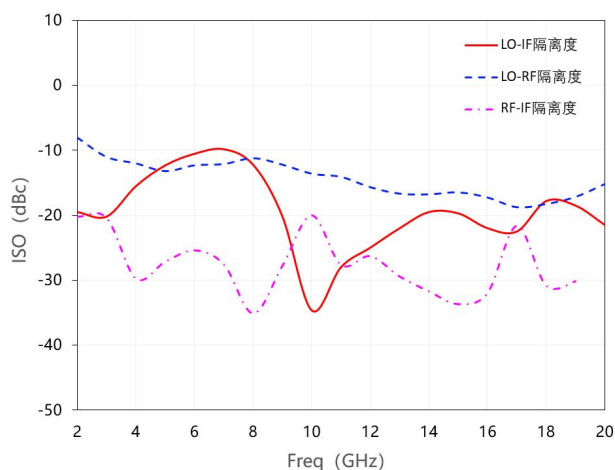
IIP3 VS 频率



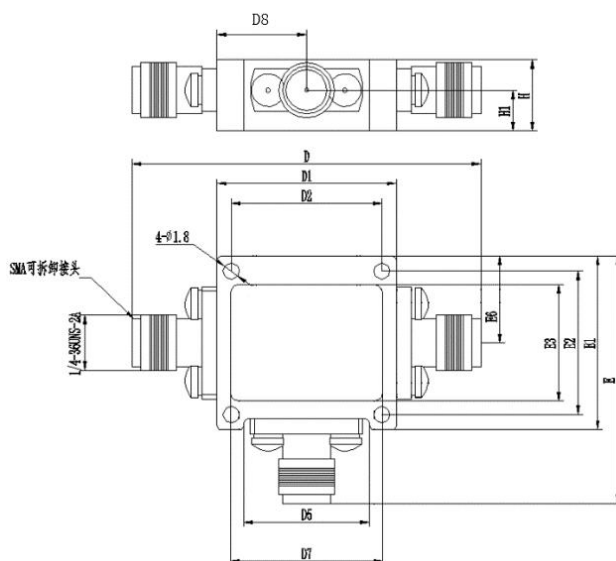
输入 1dB 压缩点 VS 频率



隔离度 VS 频率



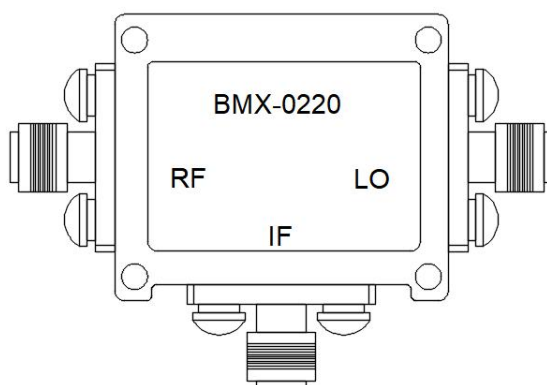
芯片尺寸图 : (单位 mm)





尺寸符号	数值 (单位 : mm)		
	最小	典型	最大
D	38.9	39.1	39.3
D1	20	20.1	20.2
D2	16.8	16.9	17.0
D5 (设计保证)	14.0	14.1	14.2
D7 (设计保证)	17.0	17.1	17.2
E	27.8	28	28.2
E1	19.4	19.5	19.6
E2	16.0	16.1	16.2
E3 (设计保证)	13.0	13.1	13.2
E6 (设计保证)	9.65	9.75	9.85
D8 (设计保证)	9.95	10.05	10.15
H	7.9	8.0	8.1
H1 (设计保证)	4.48	4.58	4.68

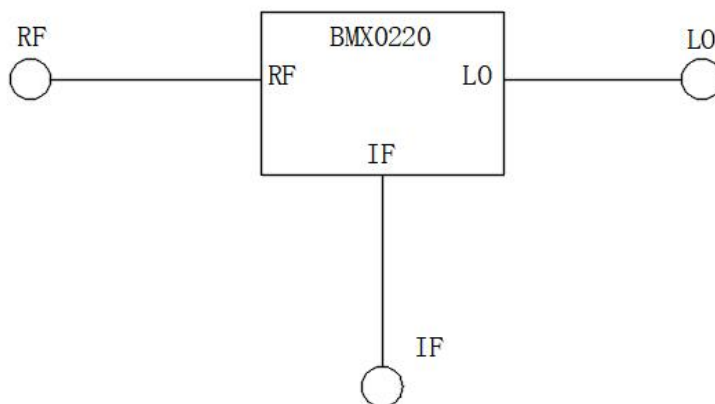
管脚定义与功能：



端口	名称
RF	射频信号端口
LO	本振信号端口
IF	中频信号端口



应用电路建议：



使用注意事项：

- 1、芯片需要贮存在干燥洁净的 N₂ 环境中；
- 2、电路为静电敏感器件，请严格遵守 ESD 防护，避免裸芯片静电损坏；
- 3、使用时，芯片务必保证接地良好；
- 4、建议使用直径 25μm 的金丝键合；
- 5、电源供电禁止反接，以免使得器件永久损坏。